

Шамирзаев Тимур Сезгирович

Доктор физико-математических наук (01.04.10 – физика полупроводников), доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и технологии гетероструктур Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Института физики полупроводников» Сибирского отделения Российской академии наук им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск +7 (383) 330-44-75, e-mail: tim@isp.ncs.ru

- [1] Fedina L. I. Structural Transformations of the Dislocation Cores in Si and Their Relationship with Photoluminescence / L. I. Fedina, A. K. Gutakovskii, V. I. Vdovin, T. S. Shamirzaev // *Crystallogr. Rep.* – 2021. – Vol. 66. – №. 4. – P. 636-643.
- [2] Golyashov V. A. Spectral detection of spin-polarized ultra low-energy electrons in semiconductor heterostructures / V.A.Golyashov, V.S.Rusetsky, T.S.Shamirzaev, D.V.Dmitrieva, N.V.Kislykh, A.V.Mironov, V.V.Aksenov, O.E.Tereshchenko // *Ultramicroscopy*. – 2020. – Vol. 218. – P. 113076.
- [3] Abramkin D. S. GaAs/GaP Quantum-Well Heterostructures Grown on Si Substrates / D. S. Abramkin, M. O. Petrushkov, M. A. Putyato, B. R. Semyagin, E. A. Emelyanov, V. V. Preobrazhenskii, A. K. Gutakovskii, T. S. Shamirzaev // *Semiconductors*. – 2019. – Vol. 53. – №. 9. – P. 1143-1147.
- [4] Abramkin D. S. Type-I Indirect-Gap Semiconductor Heterostructures on (110) Substrates / D. S. Abramkin, T. S. Shamirzaev // *Semiconductors*. – 2019. – Vol. 53. – №. 5. – P. 703-710.
- [5] Rautert J. Optical orientation and alignment of excitons in direct and indirect band gap (In, Al) As/AlAs quantum dots with type-I band alignment / J. Rautert, T. S. Shamirzaev, S. V. Nekrasov, D. R. Yakovlev, P. Klenovský, Yu. G. Kusrayev, M. Bayer // *Phys. Rev. B*. – 2019. – Vol. 99. – №. 19. – P. 195411.
- [6] Fedina L. I. On the structure and photoluminescence of dislocations in silicon / L. I. Fedina, A. K. Gutakovskii, T. S. Shamirzaev // *J. Appl. Phys.* – 2018. – Vol. 124. – №. 5. – P. 053106.
- [7] Abramkin D. S. Heterostructures with diffused interfaces: Luminescent technique for ascertainment of band alignment type / D. S. Abramkin, A. K. Gutakovskii, T. S. Shamirzaev // *J. Appl. Phys.* – 2018. – Vol. 123. – №. 11. – P. 115701.
- [8] Abramkin D. S. Spinodal Decomposition in InSb/AlAs Heterostructures / D. S. Abramkin, A. K. Bakarov, A. K. Gutakovskii, T. S. Shamirzaev // *Semiconductors*. – 2018. – Vol. 52. – №. 11. – P. 1392-1397.
- [9] Abramkin D. S. Heterostructures with InAs/AlAs Quantum Wells and Quantum Dots Grown on GaAs/Si Hybrid Substrates / D. S. Abramkin, M. O. Petrushkov, M. A. Putyato, B. R. Semyagin, T. S. Shamirzaev // *Semiconductors*. – 2018. – Vol. 52. – №. 11. – P. 1484-1490.
- [10] Shevlyagin A. V. A room-temperature-operated Si LED with β -FeSi₂ nanocrystals in the active layer: μ W emission power at 1.5 μ m / A. V. Shevlyagin, D. L. Goroshko, E. A. Chusovitin, S. A. Balagan, S. A. Dotsenko, K. N. Galkin, N. G. Galkin, T. S. Shamirzaev, A. K. Gutakovskii, A. V. Latyshev, M. Iinuma, Y. Terai // *J. Appl. Phys.* – 2017. – Vol. 121. – №. 11. – P. 113101.